

<b>信頼性試験結果</b> <b>Reliability Test Result</b>	<b>Package(Type)</b> <b>EMT5</b>	ローム株式会社 トランジスタ・ダイオードユニット  ROHM CO., LTD. Transistor/Diode Unit
	<b>品名(Product)</b> <b>Complex Bipolar Transistor</b> <b>(Pb Free)</b>	
<b>作成日(Date) : 9/Feb/2010</b>		

## 1. 試験結果(TEST RESULT)

試験項目 (TEST ITEM)	試験条件 (TEST CONDITION)	準拠規格 (STANDARD)	n[pcs] (Sample QTY.)	Pn[pcs] (NG QTY.)
はんだ耐熱性 Soldering heat resistance	260±5°C, 10秒, リフロー方式 2回	EIAJ ED-4701/300 Test Method 301	22	0
	260±5°C, 10sec., Reflow method 2times			
	260±5°C, 10秒, はんだ槽			
	260±5°C, 10sec., Solder-bath			
はんだ付け性 Solderability	350±10°C, 3秒, 手付け	-	22	0
	350±10°C, 3sec., Hand soldering			
はんだ付け性 Solderability	245±5°C, 3秒, リフロー方式	-	22	0
	245±5°C, 3sec., Reflow method			
	245±5°C, 3秒, はんだ槽			
温度サイクル Temperature cycle	245±5°C, 3sec., Solder-bath	EIAJ ED-4701/300 Test Method 303	22	0
	-55±5°C→150±5°C 200サイクル	EIAJ ED-4701/100 Test Method 105	22	0
高温高湿度逆バイアス High temp. high humidity reverse bias	-55±5°C→150±5°C 200cycles	EIAJ ED-4701/100 Test Method 102	22	0
	85±2°C, 85±5%RH, 規定のバイアス, 1000時間			
飽和蒸気加圧 PCT Pressure cooker test	85±2°C, 85±5%RH, specified bias, 1000hours	JESD22-A102C	22	0
	121±2°C, 100%RH, 203kPa, 100時間			
高温逆バイアス High temperature reverse bias	121±2°C, 100%RH, 203kPa, 100hours	EIAJ ED-4701/100 Test Method 101	22	0
	Ta=Tstg max, 規定のバイアス, 1000時間			
高温保存 High temperature storage	Ta=Tstg max., specified bias, 1000hours	EIAJ ED-4701/200 Test Method 201	22	0
	Tstg max., 1000時間			
低温保存 Low temperature storage	Tstg max., 1000hours	EIAJ ED-4701/200 Test Method 202	22	0
	Tstg min., 1000時間			
端子強度(引っ張り) Lead strength (lead pull)	Tstg min., 1000hours	EIAJ ED-4701/400 Test Method 401	22	0
	製品固定状態で軸方向荷重0.5N, 10±1sec保持.			
負荷寿命 Load Life	Sample body fixed, pulling lead axis direction, 0.5N, 10±1sec.	-	22	0
	25°C, Pc=Pc max. 1000時間			
熱衝撃 Thermal shock	25°C, Pc=Pc max. 1000hours	-	22	0
	0°C ~ 100°C, 100サイクル			
耐溶剤性 Permanence of marking	0°C ~ 100°C, 100cycles	EIAJ ED-4701/500 Test Method 501	22	0
	イソプロピルアルコール, 23±5°C, 5分			
	IPA, 23±5°C, 5min.			

## 2. 測定項目及び故障判定基準(FAILURE CRITERIA)

測定項目 (ITEM)		測定条件 (CONDITION)	故障判定基準 (CRITERIA)	
DTR	出力電流 : Io(off) Output current : Io(off)	仕様書条件による Per specification	規格値の2倍以内 Within two times of the standard value.	
	増幅率 : GI DC current gain : GI	仕様書条件による Per specification	規格値の2倍以内 Within two times of the standard value.	
共通	外観 Physical	目視 Visual check	著しい変化のないこと No outstanding change in physical.	
	はんだ付け性 Solderability	目視 Visual check	リフロー方式 Reflow method	不濡れ(ランクC)無きこと Non-wetting (rank C) unseen.
DI	順方向電圧 : VF Forward voltage : VF	仕様書条件による Per specification	はんだ槽 Solder-bath	電極部の95%以上がはんだで覆われていること More than 95% of the electrode must be covered with solder.
	逆方向電流 : IR Reverse current : IR	仕様書条件による Per specification	規格値の2倍以内 Within two times of the standard value.	
共通	外観 Physical	目視 Visual check	初期値に対する変化率 ±20% Changing rate of ±20%	
	はんだ付け性 Solderability	目視 Visual check	著しい変化のないこと No outstanding change in physical.	
			リフロー方式 Reflow method	不濡れ(ランクC)無きこと Non-wetting (rank C) unseen.
			はんだ槽 Solder-bath	電極部の95%以上がはんだで覆われていること More than 95% of the electrode must be covered with solder.

## 3. 判定結果(JUDGEMENT)

各試験項目とも不具合の発生は認められておりません。  
No failure is observed from each test item.